

9FW



PTO/SB/21 (08-03)

Approved for use through 08/30/2003. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FORM (to be used for all correspondence after initial filing)	Application Number	10/709,524	
	Filing Date	05/12/2004	
	First Named Inventor	Yin-Chang Chen	
	Art Unit		
	Examiner Name		
Total Number of Pages in This Submission	3	Attorney Docket Number	AMIP0028USA

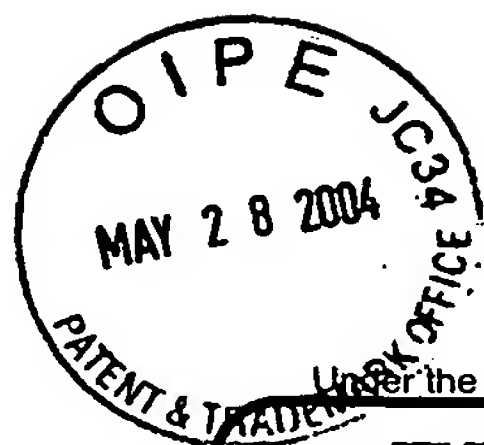
ENCLOSURES (Check all that apply)		
<input checked="" type="checkbox"/> Fee Transmittal Form <input type="checkbox"/> Fee Attached <input type="checkbox"/> Amendment/Reply <input type="checkbox"/> After Final <input type="checkbox"/> Affidavits/declaration(s) <input type="checkbox"/> Extension of Time Request <input type="checkbox"/> Express Abandonment Request <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement <input checked="" type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s) <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts/Incomplete Application <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	<input type="checkbox"/> Drawing(s) <input type="checkbox"/> Licensing-related Papers <input type="checkbox"/> Petition <input type="checkbox"/> Petition to Convert to a Provisional Application <input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation <input type="checkbox"/> Change of Correspondence Address <input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer <input type="checkbox"/> Request for Refund <input type="checkbox"/> CD, Number of CD(s) _____	<input type="checkbox"/> After Allowance communication to Technology Center (TC) <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences <input type="checkbox"/> Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) <input type="checkbox"/> Proprietary Information <input type="checkbox"/> Status Letter <input type="checkbox"/> Other Enclosure(s) (please identify below):
Remarks		

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT	
Firm or Individual name	Winston Hsu, Reg. No.: 41,526
Signature	<i>Winston Hsu</i>
Date	5/27/2004

CERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING			
I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below.			
Typed or printed name			
Signature		Date	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



PTO/SB/17 (10-03)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANSMITTAL for FY 2004

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

☐ Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00

Complete if Known

Application Number	10/709,524
Filing Date	05/12/2004
First Named Inventor	Yin-Chang Chen
Examiner Name	
Art Unit	
Attorney Docket No.	AMIP0028USA

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)

☐ Check ☐ Credit card ☐ Money Order ☐ Other ☐ None

☒ Deposit Account:

Deposit Account Number: 50-3105
Deposit Account Name: North America Intellectual Property Corp.

The Director is authorized to: (check all that apply)

☒ Charge fee(s) indicated below ☐ Credit any overpayments

☒ Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)

☐ Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.

FEE CALCULATION

1. BASIC FILING FEE

Large Entity		Small Entity		Fee Description	Fee Paid
Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)		
1001	770	2001	385	Utility filing fee	
1002	340	2002	170	Design filing fee	
1003	530	2003	265	Plant filing fee	
1004	770	2004	385	Reissue filing fee	
1005	160	2005	80	Provisional filing fee	
SUBTOTAL (1)					(\$) 0.00

2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE

Total Claims		Extra Claims		Fee from below		Fee Paid	
Independent Claims		- 20** =		X		=	
Multiple Dependent		- 3** =		X		=	

Large Entity		Small Entity		Fee Description
Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)	
1202	18	2202	9	Claims in excess of 20
1201	86	2201	43	Independent claims in excess of 3
1203	290	2203	145	Multiple dependent claim, if not paid
1204	86	2204	43	** Reissue independent claims over original patent
1205	18	2205	9	** Reissue claims in excess of 20 and over original patent

SUBTOTAL (2) (\$) 0.00

**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above

FEE CALCULATION (continued)

3. ADDITIONAL FEES

Large Entity		Small Entity		Fee Description	Fee Paid
Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)		
1051	130	2051	65	Surcharge - late filing fee or oath	
1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
1053	130	1053	130	Non-English specification	
1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
1252	420	2252	210	Extension for reply within second month	
1253	950	2253	475	Extension for reply within third month	
1254	1,480	2254	740	Extension for reply within fourth month	
1255	2,010	2255	1,005	Extension for reply within fifth month	
1401	330	2401	165	Notice of Appeal	
1402	330	2402	165	Filing a brief in support of an appeal	
1403	290	2403	145	Request for oral hearing	
1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional	
1501	1,330	2501	665	Utility issue fee (or reissue)	
1502	480	2502	240	Design issue fee	
1503	640	2503	320	Plant issue fee	
1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
1807	50	1807	50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
1806	180	1806	180	Submission of Information Disclosure Stmt	
8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1809	770	2809	385	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
1810	770	2810	385	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
1801	770	2801	385	Request for Continued Examination (RCE)	
1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application	

Other fee (specify) _____

*Reduced by Basic Filing Fee Paid

SUBTOTAL (3) (\$) 0.00

SUBMITTED BY

(Complete (if applicable))

Name (Print/Type)	Winston Hsu	Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	886289237350
Signature	<i>Winston Hsu</i>	Date	5/27/2004		

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



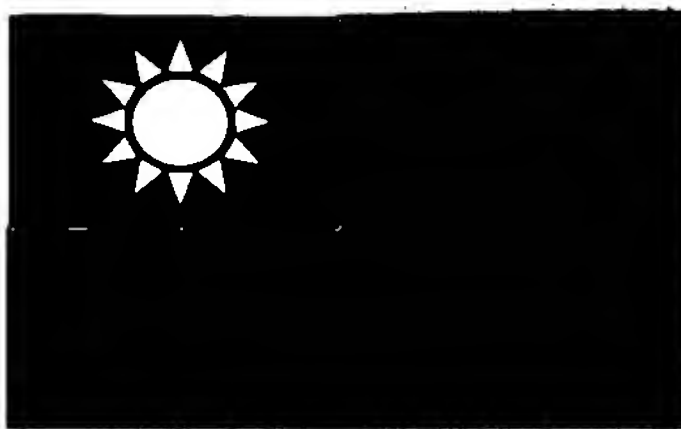
PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:					
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached?	
				YES	NO
093105761	Taiwan R.O.C	03/04/2004	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件，係本局存檔中原申請案的副本，正確無訛，
其申請資料如下：

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this
office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申請日：西元 2004 年 03 月 04 日
Application Date

申請案號：093105761
Application No.

申請人：聯笙電子股份有限公司
Applicant(s)

局長
Director General

蔡練生

發文日期：西元 2004 年 5 月 7 日
Issue Date

發文字號：09320409050
Serial No.

發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※ 申請案號：

※ 申請日期：

※IPC 分類：

壹、發明名稱：(中文/英文)

具有負電壓穩壓電路之半導體元件/ SEMICONDUCTOR DEVICE WITH A
NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR

貳、申請人：(共 1 人)

姓名或名稱：(中文/英文)

聯笙電子股份有限公司/AMIC TECHNOLOGY CORPORATION

代表人：(中文/英文) 陳焜錄/CHEN, KUN-LUH

住居所或營業所地址：(中文/英文)

新竹市新竹科學園區力行六路二號/ No. 2, Li-Hsing 6 Rd.,
Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu City 300, Taiwan, R.O.C.

國 籍：(中文/英文) 中華民國/TW

參、發明人：(共 1 人)

姓 名：(中文/英文)

陳印章/ CHEN, YIN-CHANG

住居所地址：(中文/英文)

新竹縣竹北市縣政七街二十三號三樓/ 3F, No. 23, Shianjeng 7th St.,
Jubei City, Hsin-Chu Hsien 302, Taiwan, R.O.C.

國 籍：(中文/英文) 中華民國/TW

肆、聲明事項：

☐ 本案係符合專利法第二十條第一項☐第一款但書或☐第二款但書規定之期間，其日期為： 年 月 日。

◎本案申請前已向下列國家（地區）申請專利 ☐ 主張國際優先權：

【格式請依：受理國家（地區）；申請日；申請案號數 順序註記】

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

☐ 主張國內優先權（專利法第二十五條之一）：

【格式請依：申請日；申請案號數 順序註記】

- 1.
- 2.

☐ 主張專利法第二十六條微生物：

☐ 國內微生物 【格式請依：寄存機構；日期；號碼 順序註記】

☐ 國外微生物 【格式請依：寄存國名；機構；日期；號碼 順序註記】

☐ 熟習該項技術者易於獲得，不須寄存。

伍、中文發明摘要：

本發明提供一具有負電壓穩壓電路之半導體元件。該元件包括一負電壓穩壓電路，該負電壓穩壓電路包含一驅動單元，包含二電晶體；二操作放大器，分別用來依據一迴授電壓以及一參考電壓控制該二電晶體之電流；一包含二 n 型通道三重井金氧半電晶體之電流源，該二 n 型通道三重井金氧半電晶體之汲極分別電連於該驅動單元之二電晶體之汲極，以及該二 n 型通道三重井金氧半電晶體之源極為該負電壓穩壓電路之輸入端；以及一分壓單元，用來將該負輸出電壓分壓後輸出至該二操作放大器以分別調整該驅動單元之二電晶體之電流，進而穩定該負輸出電壓。

陸、英文發明摘要：

Abstract:

A semiconductor device with a negative voltage regulator. The device includes a negative voltage regulator. The negative voltage regulator comprises a driver, two operational amplifiers, two n-type triple-well MOS transistors, and a biasing circuit. The negative output voltage feeds back to the negative voltage regulator from the biasing circuit so as to be regulated by the negative voltage regulator.

柒、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第(三)圖。

(二)本代表圖之元件代表符號簡單說明：

300	半導體元件
310	電壓源穩壓電路
320	電流源
330	參考電壓產生器
340	分壓單元
350	單元
361, 362, 363	操作放大器
R31, R32	電阻
V_{ref31} , V_{ref32} , V_{DD} , V_{OUT3} , V_{IN3}	電壓
N_{IN} , N_{OUT} , N_{FEBK3}	節點

捌、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

無

玖、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

本發明提供一種具有負電壓穩壓電路(negative voltage regulator)之半導體元件，尤指一種具有一使用三重井(triple-well)金屬氧化物半導體(Metal-Oxide-Semiconductor, MOS)電晶體，用來將一負電壓穩壓後輸出之負電壓穩壓電路之半導體元件。

【先前技術】

目前市面上之各種電子產品中，常常會使用到穩壓電路來執行電壓調整的工作，並提供穩定的電壓予設置於穩壓電路外部之元件。為了提供穩定的電壓，增加電路元件之穩定性及確保電子裝置之性能，各界皆提出許多不同的穩壓電路之設計，例如 Tanzawa 等人提出的 US Patent 6,600,692, “Semiconductor Device with a Voltage Regulator”。

一般說來，大部份的電路皆需要將電壓升壓或偏壓在一較高之正電壓(positive voltage)以使得電路有較好之效能。然而，仍然有部份電路需要使用負電壓(negative voltage)，例如像是現代資訊產品中極重要的非揮發性記憶裝置：電性可抹除唯讀記憶體(electrical erasable programmable read only memory, EEPROM)及快閃記憶體(flash memory)，當快閃記憶體於清除所寫入的資料時，即需要用到負電壓。然而，目前各界對於穩壓電路之研究與發明皆集中專注在正電壓之穩壓方面，關於負電壓之穩壓技術則並無充足之演進，如上述 US Patent 6,600,692, “Semiconductor Device with a Voltage Regulator” 所提出之穩壓電路即不適用於負電壓之穩壓。一般來說，電路中常以一負電充電電路(negative pump)來產生一負電壓。請參考圖一。圖一為一習知負電

壓產生電路 100 之示意圖。110 為一振盪器，120 為一負電充電電路。振盪器 110 將其輸出輸入負電充電電路 120，再由負電充電電路 120 輸出一負電壓 V_{OUT1} 。請參見圖二。圖二為一習知負電壓穩壓電路 200 之示意圖。負電壓穩壓電路 200 中包括一及閘 230，一分壓單元 240 以及一比較器 250。 V_{ref21} 與 V_{ref22} 為二參考電壓， $R21$ 與 $R22$ 為二分壓電阻。相較於圖一中 V_{OUT1} 之未經穩壓，分壓單元 240 以分壓電阻 $R21$ 與 $R22$ 將負電充電電路 220 之輸出 V_{OUT2} 與 V_{ref1} 分壓，再將此分壓產生之電壓 V_{FEBK2} 迴授輸入比較器 250 與參考電壓 V_{ref22} 相比較；比較器 250 之輸出與振盪器 210 之輸出一起輸入及閘 230，及閘 230 之輸出再輸入負電充電電路 220，如此形成一穩壓迴路， V_{OUT2} 即為一經穩壓之負電壓輸出 (regulated negative output voltage)。

對於要求高效能的電路來說，圖二中之習知負電壓穩壓電路 200 之穩壓效果並不夠理想。圖二中習知負電壓穩壓電路 200 運作的情形可描述如下。當 V_{OUT2} 之準位低於目標準位時，迴授電壓 V_{FEBK} 會被拉低而使得比較器 250 之輸出為數位 0 (低準位)，如此將使得及閘 230 之輸出為數位 0，亦即使得負電充電電路停止隨著振盪器 210 充電而拉高 V_{OUT2} 之準位。反之，當 V_{OUT2} 之準位高於目標準位時，迴授電壓 V_{FEBK} 會被拉高而使得比較器 250 之輸出為數位 1 (高準位)，如此將使得及閘 230 之輸出為數位 1，亦即使得負電充電電路隨著振盪器 210 充電而降低 V_{OUT2} 之準位。如上所述之迴授穩壓方式受限於比較器 250 以及及閘 230 之比較範圍，類似為一數位式之迴授穩壓，使得經穩壓後之 V_{OUT2} 仍有偏大之準位起伏，無法充份滿足需要使用負電壓之電路。

【發明內容】

因此本發明之主要目的在於提供一種具有負電壓穩壓電路之半導體元件，以改善上述問題。

根據本發明之申請專利範圍，係揭露一種具有負電壓穩壓電路(negative voltage regulator)之半導體元件，其包括一負電壓穩壓電路，用來將一負輸入電壓(Negative Input Voltage)穩壓後於一輸出節點(Output Node)輸出一負輸出電壓(Negative Output Voltage)。該負電壓穩壓電路包含一驅動單元(driver)，用來調整該負輸出電壓，該驅動單元包含一第一電晶體，一第二電晶體，一第一節點以及一輸出節點，其中該第一節點電連於一電壓源，以及該輸出節點電連於該負電壓穩壓電路之輸出節點；一第一操作放大器(operational amplifier)，其包含一第一接收端，一第二接收端以及一輸出端，分別電連於一迴授電壓(Feedback Voltage)，一參考電壓(Reference Voltage)以及該第一電晶體，該第一操作放大器係依據該迴授電壓以及該參考電壓以於該輸出端輸出一驅動電壓以控制流經該第一電晶體之電流；一第二操作放大器，該第二操作放大器包含一第一接收端，一第二接收端以及一輸出端，分別電連於一參考電壓，該迴授電壓以及該輸出端電連於該第二電晶體，該第二操作放大器係依據該參考電壓以及該迴授電壓以於該輸出端輸出一驅動電壓以控制流經該第二電晶體之電流；一電流源(current source)，用來提供該驅動單元電流，該電流源包含二 n 型通道三重井(triple-well)金屬氧化物半導體(Metal-Oxide-Semiconductor, MOS, 金氧半)電晶體，其中該二 n 型通道三重井金氧半電晶體之汲極分別電連於該第一電晶體之汲極以及該第二電晶體之汲極，以及該二 n 型通道三重井金氧半電晶體之源極(Source)與該負輸入電壓相連；以及一分壓單元，包含一第一端點及一第二端點，分別電連於一電壓源及該輸出節點，該分壓單元另包含一迴授節點，該迴授節點電連於該第一操作放大器之第一接收端和該第二操作放大器之第二接收端，該分壓單元係用來將該電壓源之位準以及該負輸出電壓分壓以形成該迴授電壓，而於該迴授節點輸出該迴授電壓至該第一操作放大器以及該第二操作放大器，以調整控制流經該第一電晶體以及該第二電晶體之電流，進而穩定該負輸出電壓。

【實施方式】

請參閱圖三。圖三為本發明之具有負電壓穩壓電路之半導體元件 300 之示意圖。30 為本發明之負電壓穩壓電路，其由一電壓源穩壓電路 310，一電流源電路 320，一分壓單元 340，一驅動單元(driver)350 以及兩個操作放大器 361 與 362 所組成。需經穩壓之負輸入電壓 (Negative Input Voltage) V_{IN3} 經由輸入節點(Input Node) N_{IN} 輸入負電壓穩壓電路 30，經負電壓穩壓電路 30 穩壓後於輸出節點(Output Node) N_{OUT} 輸出一經穩壓之負輸出電壓 (Regulated Negative Output Voltage) V_{OUT3} 。330 則為本發明之具有負電壓穩壓電路之半導體元件 300 所包含之一參考電壓產生器(Band Gap Circuit)，用來產生元件 300 中各電路所需之參考電壓(Reference Voltage)，包括如圖三所示之二參考電壓 V_{ref31} 與 V_{ref32} 。

以下依序說明圖三中本發明之具有負電壓穩壓電路之半導體元件 300 中各部份電路之結構與功能。電壓源穩壓電路 310 係用來於節點 N_s 產生一穩定電壓源 V_s 。電壓源穩壓電路 310 包括一 p 型通道金屬氧化物半導體(Metal-Oxide-Semiconductor, MOS, 金氧半)電晶體 p3 以及一操作放大器(operational amplifier)363。電晶體 p3 以其源極(source)與元件 300 之電壓源，例如為整個電路之高準位電源 V_{DD} 相連，以及以其汲極(drain)電連於節點 N_s ；操作放大器 363 則如圖三所示，以其二接收端分別電連於電晶體 p3 之汲極(drain)與參考電壓產生器 330 所提供之一參考電壓 V_{ref31} ，以及以其輸出端電連於電晶體 p3 之閘極(gate)。電壓源穩壓電路 310 可將電晶體 p3 之汲極之電壓準位固定在參考電壓 V_{ref31} 之準位而獨立於非穩定電源 V_{DD} 之影響之外，提供一穩定電壓源 V_s 。電流源電路 320 包含二 n 型通道三重井(triple-well)金氧半電晶體 n1 與 n2，電晶體 n1 與 n2 上所通過之電流呈固定之比例關係。電晶體 n1 與 n2 之源極與輸入節點 N_{IN} 相連，而因為電晶體 n1 與 n2 為三重井(triple-well)金氧半電晶體，因此可以於其汲極與源極連

接負電壓，負輸入電壓 V_{IN3} 即由電晶體 $n1$ 與 $n2$ 之源極輸入負電壓穩壓電路 30。分壓單元 340 係用來將負輸出電壓 V_{OUT3} 分壓後迴授輸入本發明之負電壓穩壓電路 30，可有許多不同之實施方法，圖三所示為最簡易之一實施例。如圖三所示，分壓單元 340 包含兩分壓電阻 $R31$ 與 $R32$ ，分壓單元 340 之兩端分別電連於負電壓穩壓電路 30 之輸出節點 N_{OUT} 與節點 N_s 以將電壓 V_s 與負輸出電壓 V_{OUT3} 分壓後於迴授節點 N_{FEBK3} 迴授輸入負電壓穩壓電路 30。再來介紹驅動單元 350。驅動單元 350 包含二 p 型通道金氧半電晶體 $p1$ 與 $p2$ ，電晶體 $p1$ 與 $p2$ 之源極電連於節點 N_s 而接收穩定電壓源 V_s ，電晶體 $p1$ 與 $p2$ 之閘極則分別電連於操作放大器 361 與 362 之輸出端，由操作放大器 361 與 362 之輸出電壓分別控制流經電晶體 $p1$ 與 $p2$ 上之電流 I_1 與 I_2 。操作放大器 361 與 362 各自以其一接收端接收參考電壓產生器 330 所產生之參考電壓 V_{ref32} ，而以其另一接收端電連於迴授節點 N_{FEBK3} 接收迴授電壓 V_{FEBK3} 。

根據圖三所示以及以上所述，本發明之負電壓穩壓電路運作的情形可描述如下。首先，電壓源穩壓電路 310 以及分壓單元 340 經妥善設計，參考電壓 V_{ref31} 與 V_{ref32} 之值也加以配合選取後，當負輸出電壓 V_{OUT3} 高於目標準位時，迴授電壓 V_{FEBK3} 會跟著上升而高於 V_{ref32} ；此時操作放大器 361 之輸出電壓為高準位而操作放大器 362 之輸出電壓為低準位，導致電晶體 $p1$ 上所流之電流 I_1 變小而電晶體 $p2$ 上所流之電流 I_2 變大。然而，電晶體 $n1$ 與 $n2$ 上所流之電流互呈比例，因此在電晶體 $p1$ 上所流之電流 I_1 變小而電晶體 $p2$ 上所流之電流 I_2 變大的情況下，必須有電流從分壓電路 340 經輸出節點 N_{OUT} 流入電晶體 $n1$ 以補電流 I_1 之不足；此電流將使得迴授電壓 V_{FEBK3} 與負輸出電壓 V_{OUT3} 皆被拉低，即透過負電壓穩壓電路 30 之迴授，將原本高於目標準位之負輸出電壓 V_{OUT3} 調低回目標準位。反之，若負輸出電壓 V_{OUT3} 低於目標準位時，迴授電壓 V_{FEBK3} 會跟著下降而低於 V_{ref32} ；此時操作放大器 361 之輸出電壓為低準位而操作放大器 362 之輸出電壓為高準位，導致電晶體 $p1$ 上所流之電流 I_1 變大而電晶體 $p2$ 上所流之電流 I_2 變小。同理，在電晶體 $p1$ 上所流

之電流 I_1 變大而電晶體 $p1$ 上所流之電流 I_2 變小的情況下，電流 I_1 之部份電流將從輸出節點 N_{OUT} 流出至分壓單元 340；此電流將使得迴授電壓 V_{FEK3} 與負輸出電壓 V_{OUT3} 皆被提高，即透過負電壓穩壓電路 30 之迴授，將原本低於目標準位之負輸出電壓 V_{OUT3} 調高回目標準位。

綜上所述，本發明係將負輸出電壓 V_{OUT3} 之分壓 V_{FEK3} 迴授至負電壓穩壓電路 30 中以控制驅動單元 350 之電晶體 $p1$ 與 $p2$ 上所流經之電流 I_1 與 I_2 ，再藉電流 I_1 與 I_2 之變化以調整負輸出電壓 V_{OUT3} 之準位，將其穩壓於一目標準位。其中，本發明之一特徵在於使用二 n 型通道三重井金氧半電晶體 $n1$ 與 $n2$ 。如眾所知，電晶體之源極與基極以偏壓在同一電壓準位為佳，因此在本發明中採用 n 型通道三重井金氧半電晶體 $n1$ 與 $n2$ 組成一電流源電路，使得電晶體 $n1$ 與 $n2$ 之源極與汲極皆可接受負電壓，而以電晶體 $n1$ 與 $n2$ 之源極作為本發明之負電壓穩壓電路之輸入節點，以及以電晶體 $n1$ 之汲極作為本發明之負電壓穩壓電路之輸出節點，以適用於負輸入電壓，實現負電壓之穩壓功能。

圖三所舉為本發明之具有負電壓穩壓電路之半導體元件之一較佳實施例。本發明於實施時，分壓單元 340 之與輸出節點 N_{OUT} 相連以外之另一端點可電連於一不同於 V_s 之參考電壓 V_{ref33} ，而分壓單元 340 所包含之元件及其結構亦可有所變化，只要能妥善設計使得於迴授節點 N_{FEK3} 所產生之電壓 V_{FEK3} 可以與參考電壓 V_{ref32} 相配合以控制操作放大器 361 與 362 即可。而電壓源穩壓電路 310 亦可省略或以其他穩壓電路代替，只要能於節點 N_s 提供一穩定電壓源 V_s 即可。關於驅動單元 350 的部份，圖三中所舉為結構最簡單之實施例，亦可以結構相異但能在控制分壓電路上之電流以調整負輸出電壓 V_{OUT3} 上達同樣效果之其他電路替代。

總結來說，本發明利用三重井金氧半電晶體之特性，提供了一簡潔而有效之負電壓穩壓電路，使得需要使用負電壓之電路能得到穩定之負電壓而提高效能。且根據實際驗證，若所輸入之負輸入電壓為一負 7

伏特 (-7V) 且其上有 200 毫伏(mV)擾動之電壓時，經本發明之負電壓穩壓電路穩壓後，可輸出一-7V 而其上僅有小於 50mV 擾動之穩定電壓，足證本發明之負電壓穩壓電路可大幅降低負電壓上之雜訊而提供一良好之穩壓效果，支援了快閃記憶體於操作上之需求。

以上所述僅為本發明之較佳實施例，凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾，皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。

【圖式簡單說明】

圖式之簡單說明

圖一為一習知負電壓產生電路之示意圖。

圖二為一習知負電壓穩壓電路之示意圖。

圖三為本發明之具有負電壓穩壓電路之半導體元件之示意圖。

圖式之符號說明

100	負電壓產生電路
200, 30	負電壓穩壓電路
300	半導體元件
110, 210	振盪器
120, 220	負電充電電路
230	及閘
240, 340	分壓單元
250	比較器
310	電壓源穩壓電路
320	電流源

330	參考電壓產生器
350	驅動單元
361, 362, 363	操作放大器
R21, R22, R31, R32	電阻
V_{OUT1} , V_{OUT2} , V_{FEBK2} , V_{ref21} , V_{ref22} , V_{ref31} , V_{ref32} , V_{DD} , V_{OUT3} , V_{IN3}	電壓
N_{IN} , N_{OUT} , N_{FEBK3}	節點

拾、申請專利範圍：

1. 一種具有負電壓穩壓電路(negative voltage regulator)之半導體元件，其包含：

一負電壓穩壓電路，用來將一負輸入電壓(Negative Input Voltage)穩壓後於一輸出節點(Output Node)輸出一負輸出電壓(Negative Output Voltage)，該負電壓穩壓電路包含：

一驅動單元(driver)，用來調整該負輸出電壓，該驅動單元包含一第一電晶體與一第二電晶體，一第一節點以及一輸出節點，其中該第一節點電連於一電壓源，以及該輸出節點電連於該負電壓穩壓電路之輸出節點；

一第一操作放大器 (operational amplifier)，其包含一第一接收端，一第二接收端以及一輸出端，分別電連於一迴授電壓(Feedback Voltage)，及一參考電壓(Reference Voltage)以及該第一電晶體，該第一操作放大器係依據該迴授電壓以及該參考電壓以於該輸出端輸出一驅動電壓以控制流經該第一電晶體之電流；

一第二操作放大器，該第二操作放大器包含一第一接收端，一第二接收端以及一輸出端，分別電連於一參考電壓，該迴授電壓以及該第二電晶體，該第二操作放大器係依據該參考電壓以及該迴授電壓以於該輸出端輸出一驅動電壓以控制流經該第二電晶體之電流；

一電流源電路 (current source circuit)，用來提供該驅動單元電流，該電流源電路包含二n型通道三重井(triple-well)金屬氧化物半導體(Metal-Oxide-Semiconductor, MOS, 金氧半)電晶體，其中該二n型通道三重井金氧半電晶體之汲極分別電連於該第一電晶體之汲極以及該第二電晶體之汲極，以及該二n型通道三重井金氧半電晶體之源極(Source)與該負輸入電壓相連；以及

一分壓單元，包含一第一端點、一第二端點以及一迴授節點，其中

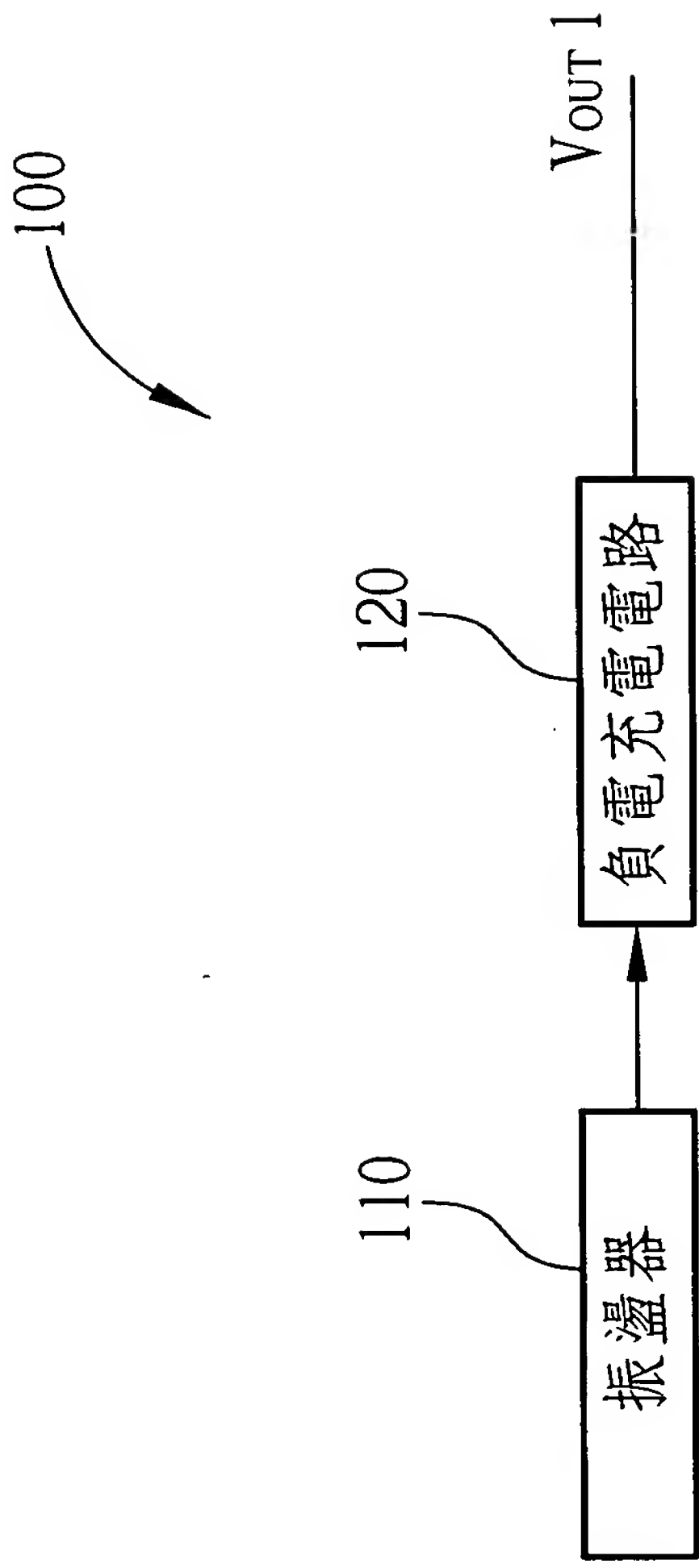
該第一端點電連於一電壓源，該第二端點電連於該輸出節點，以及該迴授節點電連於該第一操作放大器之第一接收端和該第二操作放大器之第二接收端，該分壓單元係用來將該電壓源之位準以及該負輸出電壓分壓以形成該迴授電壓，而於該迴授節點輸出該迴授電壓至該第一操作放大器以及該第二操作放大器，以調整控制流經該第一電晶體以及該第二電晶體之電流，進而穩定該負輸出電壓。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體元件，其中該第一電晶體與該第二電晶體係各為一 p 型通道金氧半電晶體。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體元件，其中該第一電晶體與該第二電晶體係各為一 p 型通道金氧半電晶體，其中該第一電晶體之源極(Source)以及該第二電晶體之源極電連於該第一電壓源，該第一電晶體之閘極電連於該第一操作放大器之輸出端，以及該第二電晶體之閘極電連於該第二操作放大器之輸出端。
4. 如申請專利範圍第 3 項所述之半導體元件，其中該驅動器之輸出節點係為該第一電晶體之汲極。
5. 如申請專利範圍第 3 項所述之半導體元件，其中該驅動器之輸出節點係為該第二電晶體之汲極。
6. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體元件，其中該二 n 型通道三重井金氧半電晶體之基極(Base)分別與其各自之源極(Source)相電連，該二 n 型通道三重井金氧半電晶體中之一 n 型通道三重井金氧半電晶體之汲極與閘極(Gate)相電連，以及該二 n 型通道三重井金氧半電晶體中之另一 n 型通道三重井金氧半電晶體之汲極電連於該驅動器之輸出節點。

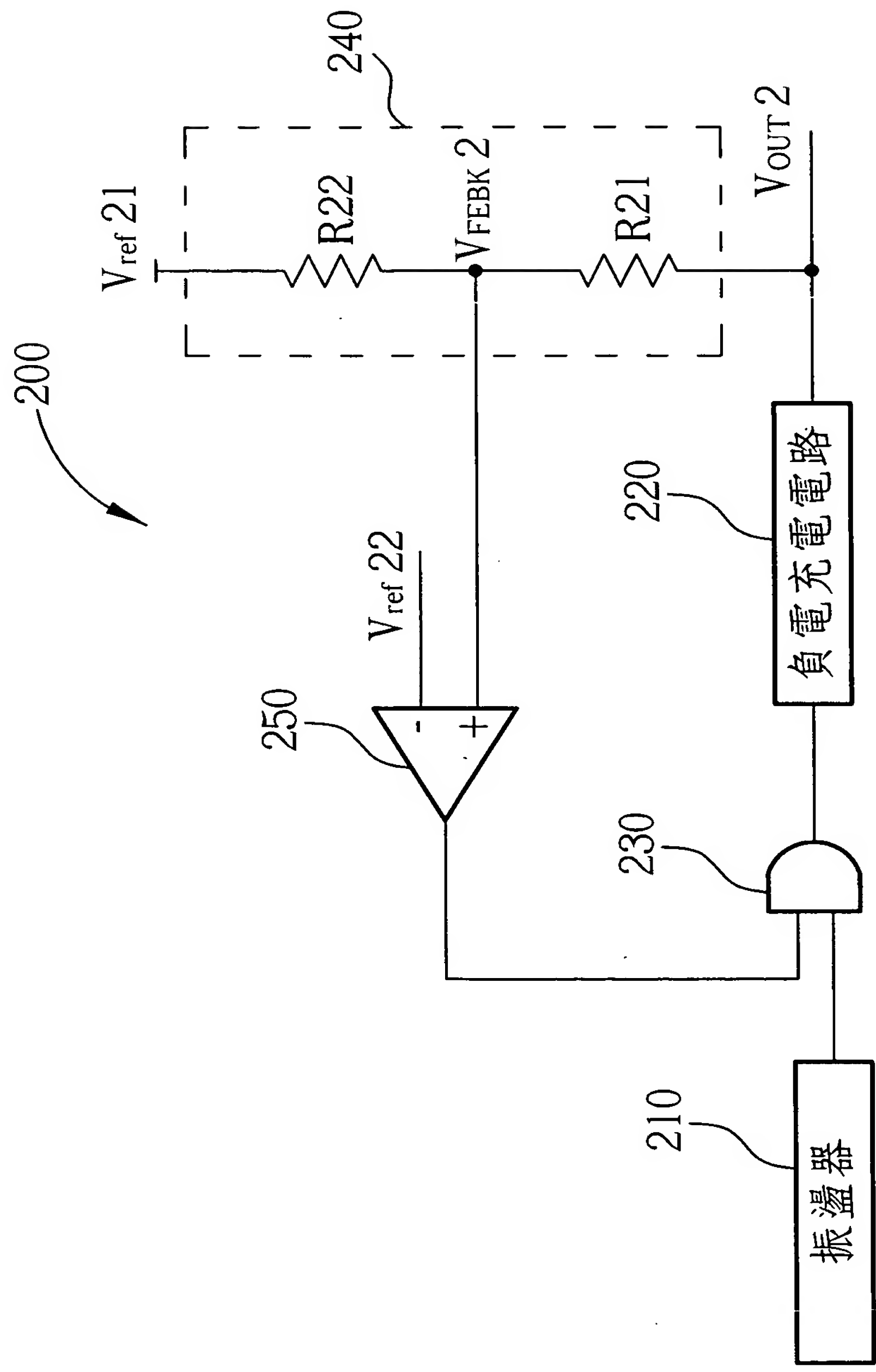
7. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體元件，其另包含一振盪器 (oscillator) 與一負電充電電路 (negative pump)，其中該振盪器之輸出端電連於該負電充電電路之輸入端，以及該負電充電電路之輸出端電連於該二 n 型通道三重井金氧半電晶體之源極。
8. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體元件，其另包含一參考電壓產生器，用來產生該第一操作放大器之參考電壓與該第二操作放大器之參考電壓。
9. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體元件，其中該驅動單元與該分壓單元係電連至同一電壓源。
10. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體元件，其另包含：
 - 一電壓源穩壓電路，用來產生與該驅動單元之第一節點相電連之電壓源，該電壓源穩壓電路包含：
 - 一 p 型通道金氧半電晶體，以其源極與一第一電壓源相連，以及以其汲極電連於該驅動單元之第一節點；以及
 - 一第三操作放大器，其包含一第一接收端，一第二接收端以及一輸出端，分別電連於該 p 型通道金氧半電晶體之汲極，一第一參考電壓以及該 p 型通道金氧半電晶體之閘極，該第三操作放大器係用來將該 p 型通道金氧半電晶體之汲極之電壓準位固定在該第一參考電壓之準位。
11. 如申請專利範圍第 10 項所述之半導體元件，其另包含一參考電壓產生器，用來產生該第一操作放大器之參考電壓，該第二操作放大器之參考電壓以及該第一參考電壓。
12. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體元件，其係為一快閃記憶體 (flash memory)。

拾壹、圖式：



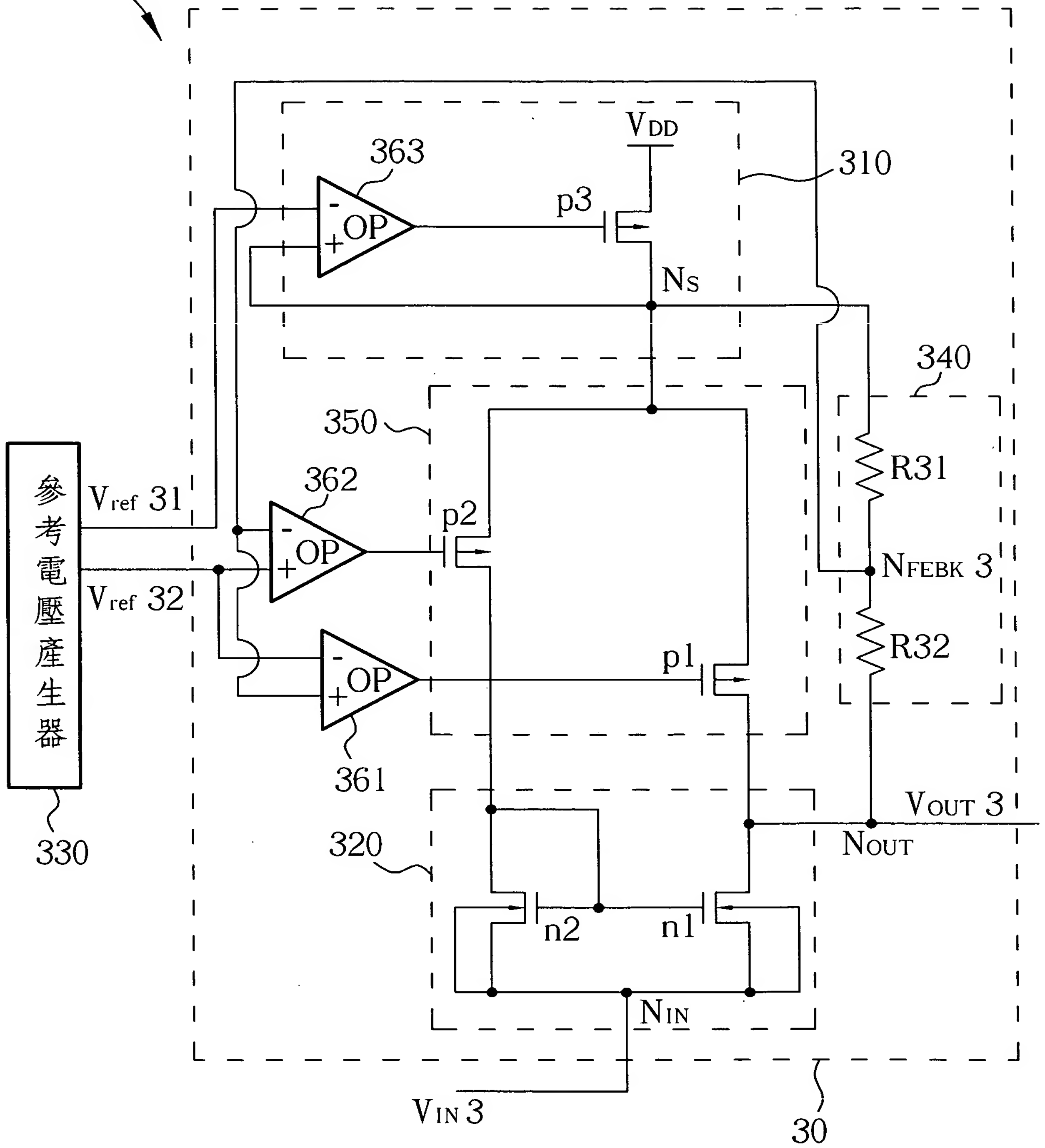


圖一



圖二

300



圖三